Ad-Soyad : Email : No : İmza :

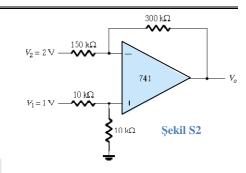
Final sınavı (01.06.2010, süre: 90 dk)

(D)

## 0112622 - Elektronik Devreler

_		112022		COLLICIO			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Toplam

- S1. Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını yandaki parantez içinde D ya da Y şeklinde belirtiniz. (15)
  - a. Termistor sıcaklığı elektriğe dönüştürür.
  - b. FET in giriş direnci BJT ye göre daha düşüktür. (Y)
  - c. BJT nin gerilim kazancı FET e göre daha yüksektir. (D)
  - d. CMOS lojik kapılar, TTL ye göre daha fazla güç harcarlar.(Y)
  - e. Ideal OPAMP in kazanci sonsuzdur. (D)
- S2. Şekil S2 de verilen devrede  $V_0$  çıkışını hesaplayınız. (15)

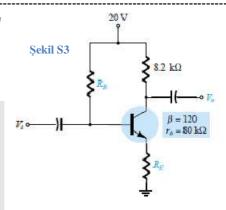


$$\frac{V_{-}-2}{150} + \frac{V_{-}-v_{0}}{300} = 0 \implies \frac{2V_{-}-4}{300} + \frac{V_{-}-v_{0}}{300} = 0 \implies v_{0} = 3V_{-}-4$$

$$V_{+} = \frac{10 \times 1}{10 + 10} = 0.5 \text{ V} \qquad V_{-} = V_{+}$$

$$v_0 = 3V_- - 4 = 3 \times 0.5 - 4 = -2.5 \text{ V}$$

S3. Şekil S3 de verilen devrede  $A_v$  = -10 ve  $r_e$  = 3.8  $\Omega$  olarak verildiğine göre;  $R_E$  ve  $R_B$  dirençlerini bulunuz. ( $Z_b$  =  $\beta R_E$  olduğunu varsayın) (20)



$$A_{v} = -\frac{\beta R_{C}}{Z_{b}} = -\frac{\beta R_{C}}{\beta R_{E}} = -\frac{R_{C}}{R_{E}} = -10 \quad \Rightarrow \quad R_{E} = \frac{R_{C}}{10} = \frac{8.2 \text{ k}\Omega}{10} = 0.82 \text{ k}\Omega$$

$$I_{E} = \frac{26 \text{ mV}}{r_{e}} = \frac{26 \text{ mV}}{3.8 \Omega} = 6.842 \text{ mA}$$

$$V_{E} = I_{E}R_{E} = 6.842 \text{ mA} \times 0.82 \text{ k}\Omega = 5.61 \text{ V}$$

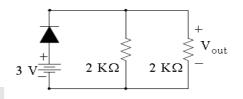
$$V_B = V_E + V_{BE} = 5.61 \text{ V} + 0.7 \text{ V} = 6.31 \text{ V}$$

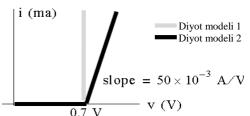
$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{6.842 \text{ mA}}{121} = 56.55 \,\mu\text{A}$$

$$R_B = \frac{V_{R_B}}{I_B} = \frac{V_{CC} - V_B}{I_B} = \frac{20 \text{ V} - 6.31 \text{ V}}{56.55 \,\mu\text{A}} = 242.09 \text{ k}\Omega$$

Hatırlatma: 
$$A_{v} = -\beta R_{C} / Z_{b}$$
  $I_{E} = 26 \text{ mV} / r_{e}$   $slope = 1/r_{D}$   $y_{os} = 1/r_{d}$   $A_{v} = -g_{m}(r_{d} \parallel R_{D})$   $I_{D} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{D}}\right)^{2}$   $g_{m} = \frac{2I_{DSS}}{|V_{c}|} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_{D}}\right]^{2}$ 

S4. a.Şekildeki diyot devresinde **diyot modeli 1** kullanıldığında devreden
geçen toplam akımı bulunuz. (7)





$$I = \frac{3 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega \| 2 \text{ k}\Omega} = \frac{2.3 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 2.3 \text{ mA}$$

b. Aynı diyot devresinde **diyot modeli 2** kullanıldığında **V**<sub>out</sub> gerilimini bulunuz. (8)

$$slope = \frac{1}{r_D} \implies r_D = \frac{1}{slope} = \frac{1}{50 \times 10^{-3}} = \frac{10^3}{50} = \frac{100}{5} = 20 \Omega$$

$$I = \frac{3 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{(2||2) \times 10^3 \Omega + 20 \Omega} = \frac{2.3 \text{ V}}{1020 \Omega} = 0.00225 \text{ A} = 2.25 \text{ mA}$$

$$V_{out} = I \times (2||2) \times 10^3 \Omega = 2.25 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^3 = 2.25 \text{ V}$$

S5. Şekil S5 de verilen devrede  $I_{DSS}$  = 6 mA,  $V_P$  = -6 V,  $V_{GSQ}$  = 0 V ve  $y_{os}$  = 40  $\mu$ S olarak verildiğine göre;  $Z_i$ ,  $Z_o$ , ve  $A_v$  değerlerini bulunuz. (20)

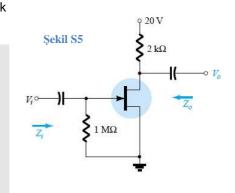
$$g_{m} = \frac{2I_{DSS}}{|V_{P}|} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{P}} \right) = \frac{2 \times 6 \text{ mA}}{|-6| \text{ V}} \left( 1 - \frac{0 \text{ V}}{-6 \text{ V}} \right) = \frac{2 \times 6 \text{ mA}}{6 \text{ V}} = 2 \text{ mS}$$

$$r_{d} = \frac{1}{y_{os}} = \frac{1}{40 \text{ µS}} = \frac{10^{6}}{40 \text{ S}} = \frac{1000 \times 10^{3}}{40 \text{ S}} = 25 \times 10^{3} \Omega = 25 \text{ k}\Omega$$

$$Z_{i} = 1 \text{ M}\Omega$$

$$Z_{o} = r_{d} \parallel R_{D} = \frac{r_{d} \times R_{D}}{r_{d} + R_{D}} = \frac{25 \text{ k}\Omega \times 2 \text{ k}\Omega}{(25 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega)} \approx 1.852 \text{ k}\Omega$$

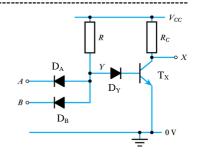
$$A_{v} = -g_{m} Z_{o} = -2 \text{ mS} \times 1.852 \text{ k}\Omega \approx -3.7$$



S6.

 a. Yandaki devrede diyot ve tranzistörlerin ideal olduğunu varsayarak devrenin nasıl çalıştığını yandaki tabloyu doldurarak açıklayınız. (10)

Α	В	$D_A$	D <sub>B</sub>	$D_Y$	$T_X$	Χ
0	0	on	on	off	off	$V_{CC}$
0	$V_{CC}$	on	off	off	off	$V_{CC}$
V <sub>CC</sub>	0	off	on	off	off	$V_{CC}$
V <sub>CC</sub>	V <sub>CC</sub>	off	off	on	on	0



A ve/veya B '0' a bağlandığında  $D_A$  ve/veya  $D_B$  iletimde,  $D_Y$  ve  $T_X$  kesimde olur. Bu durumda X çıkışı  $V_{CC}$  olur. A ve B ' $V_{CC}$ ' ye bağlandığında  $D_A$  ve  $D_B$  kesimde,  $D_Y$  ve  $T_X$  iletimde olur. Bu durumda X çıkışı '0' olur.

b. Bu devre ne iş yapar? (5)

Bu bir NAND kapısıdır.

Ad-Soyad : No :			mail :		
Vize 1 ( <b>0112622 – Ele</b>	05.04.201 ektronik D	•			
S1. (a) İdeal bir <b>işlemsel kuvvetlendirici</b> nin genel özellikle (b) <b>Kazanç×Bant genişliği = 10</b> <sup>6</sup> olan gerçek bir <b>işlem</b> devresinin kazancı <b>1000</b> olursa Bant genişliği kaç <b>I</b>	sel kuvvetler	ndirici kulla	anarak gerçel	kleştirilen bir kuv	(5) vetlendirici (10)
S2. Yandaki devre verildiğine göre; devrenin kazancını ( <b>A</b> <sub>v</sub> ), <b>R</b> <sub>1</sub> , <b>R</b> <sub>2</sub> , <b>R</b> <sub>3</sub> <b>ve R</b> <sub>f</sub> cinsinden bulı	unuz (	(20)	tvin	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Vout F
<ul> <li>S3. Yandaki devrede V<sub>z1</sub>=V<sub>z2</sub>= 6.3 V, V<sub>F</sub> = 0.7 V (zener diyo düşümü), R<sub>1</sub>= 5 kΩ ve R<sub>f</sub> = 100 kΩ olarak verildiğine g</li> <li>(a) Devrenin kazancını (A<sub>v</sub>) bulunuz.</li> <li>(b) Giriş işareti V<sub>in</sub> = 0.3 sin10t olduğunda devrenin çık</li> <li>(c) Giriş işareti V<sub>in</sub> = 0.6 cos100t olduğunda devrenin ç</li> <li>(d) Giriş işareti V<sub>in</sub> = 3 sin(1000t+ π / 6) olduğunda dev bulunuz.</li> </ul>	öre; cışını ( <b>V<sub>out</sub>)</b> cıkışını ( <b>V<sub>out</sub>)</b>	(5) (5) (5)	- in	R <sub>1</sub> R <sub>f</sub>	V <sub>out</sub>
S4. Yandaki diyot devresinde $V_{o1}$ , $V_{o2}$ ve I değerlerini bulun $V_{F(Si)} = 0.7 \ V$ $V_{F(Ge)} = 0.3 \ V$	iuz. (	(20)	V + 1 kΩ	V <sub>01</sub> 0.47 kΩ  V <sub>01</sub> 0.47 kΩ  Si	V <sub>o2</sub> Ge
<ul> <li>S5. Yandaki tranzistörlü devrede R<sub>B</sub>= 470 kΩ , R<sub>C</sub> = 3 kΩ , r<sub>0</sub> = 50 kΩ olarak verildiğine göre;</li> <li>(a) I<sub>B</sub>, I<sub>E</sub> ve r<sub>e</sub> değerlerini bulunuz.</li> <li>(b) Giriş direncini (Z<sub>i</sub>) bulunuz.</li> <li>(c) Çıkış direncini (Z<sub>o</sub>) bulunuz.</li> <li>(b) Devrenin kazancını (A<sub>v</sub>) bulunuz.</li> </ul>	β = 100 ve (10) (5) (5) (5)	$V_i \circ \longrightarrow I_i$ $C_1$ $C_1$	$R_B$	$R_{C}$ $R_{C}$ $I_{o}$ $I_{o$	$V_o$

### **CEVAPLAR**

C1. a. İdeal op-amp ın genel özellikleri:

Gerilim kazancı  $A_v = \infty$ , Giriş direnci  $R_i = \infty$ Çıkış direnci  $R_0 = 0$ 

b. Kazanç×Bant genişliği = 10<sup>6</sup>

 $Kazanç = 1000 = 10^3$ 

Bant genişliği = (Kazanç×Bant genişliği) / Kazanç =  $10^6$  /  $10^3$  =  $10^3$  Hz = 1000 Hz

\_\_\_\_\_

C2.

$$\frac{V_{1} - v_{in}}{R_{1}} + \frac{V_{1} - v_{out}}{R_{f}} = 0 \implies \left(\frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{f}}\right) V_{1} = \frac{v_{in}}{R_{1}} + \frac{v_{out}}{R_{f}} \implies \left(\frac{R_{1} + R_{f}}{R_{1}R_{f}}\right) V_{1} = \frac{R_{f}v_{in} + R_{1}v_{out}}{R_{1}R_{f}} \implies V_{1} = \frac{R_{f}v_{in} + R_{1}v_{out}}{R_{1} + R_{f}}$$

$$\frac{V_2 - v_{in}}{R_2} + \frac{V_2}{R_3} = 0 \implies \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) V_2 = \frac{v_{in}}{R_2} \implies \left(\frac{R_2 + R_3}{R_2 R_3}\right) V_2 = \frac{v_{in}}{R_2} \implies V_2 = \frac{R_3 v_{in}}{R_2 + R_3}$$

$$V_{1} = V_{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{R_{f}v_{in} + R_{1}v_{out}}{R_{1} + R_{f}} = \frac{R_{3}v_{in}}{R_{2} + R_{3}} \quad \Rightarrow \quad R_{f}v_{in} + R_{1}v_{out} = \frac{(R_{1} + R_{f})R_{3}v_{in}}{R_{2} + R_{3}} \quad \Rightarrow \quad \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_{3}(R_{1} + R_{f})}{R_{1}(R_{2} + R_{3})} - \frac{R_{f}}{R_{1}(R_{2} + R_{3})} - \frac{R_{f}}{R$$

$$G_{\rm V} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_1 R_3 - R_2 R_f}{R_1 (R_2 + R_3)}$$

\_\_\_\_\_\_

C3.

a. 
$$\frac{0 - v_{in}}{R_1} + \frac{0 - v_{out}}{R_f} = 0 \implies \frac{-v_{in}}{R_1} = \frac{v_{out}}{R_f} \implies G_V = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{R_f}{R_1} = -\frac{100}{5} = -20$$

Zener diyotlarından dolayı devrenin çıkışı  $\pm (V_{Z1} + V_F) = \pm (6.3 + 07) = \pm 7$  V değerleriyle sınırlandırılmıştır. Buna göre;

- b. Giriş işareti  $V_{in}$  = 0.3 sin10t olduğunda devrenin çıkışı ( $V_{out}$ ):
  - Tepe değerleri ±0.3×(-20)=±6 V olan kırpılmamış bir sinüsoidal bir işarettir.
- c. Giriş işareti  $V_{in} = 0.6 \cos 100t$  olduğunda devrenin çıkışı ( $V_{out}$ ):

Zener diyot olmasaydı tepe değerleri ±0.6×(-20)=±12 V olan kırpılmamış sinüsoidal bir işaret olacaktı. Ancak çıkış işareti zenerlerden dolayı kırpılacağı için çıkış işareti, tepe değerleri ±12 V olan sinüsoidal işaretin tepe değerlerinin ±7 V da kırpılmış olduğu bir periodik işaret olacaktır.

- d. Giriş işareti  $V_{in} = 3 \sin(1000t + \pi/6)$  olduğunda devrenin çıkışı ( $V_{out}$ ):
  - Zener diyot olmasaydı tepe değerleri ±3x(-20)=±60 V olan kırpılmamış sinüsoidal bir işaret olacaktı. Ancak çıkış işareti zenerlerden dolayı kırpılacağı için çıkış işareti, tepe değerleri ±60 V olan sinüsoidal işaretin tepe değerlerinin ±7 V da kırpılmış olduğu bir periodik işaret olacaktır.

C4. Her iki diyot iletim yönünde kutuplanmışlardır. Dolayısı ile ikisi de iletimdedir. Buna gore:

$$\begin{split} &V_{o1} = 0.7 \text{ V}, \quad V_{o2} = 0.3 \text{ V} \\ &I_{1 \text{k}\Omega} = \frac{20 - V_{o1}}{1 \text{ k}\Omega} = \frac{20 - 0.7}{1000} = \frac{19.3}{1000} = 0.0193 \text{ A} = 19.3 \text{ mA} \\ &I_{0.47 \text{k}\Omega} = \frac{V_{o1} - V_{o2}}{0.47 \text{ k}\Omega} = \frac{0.7 - 0.3}{470} = \frac{0.4}{470} = 0.000851 \text{ A} = 0.851 \text{ mA} \\ &I_{\text{Sidiode}} = I_{1 \text{k}\Omega} - I_{0.47 \text{k}\Omega} = 19.3 \text{ mA} - 0.851 \text{ mA} = 18.45 \text{ mA} \end{split}$$

------

C5.

a. 
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12 - 0.7}{470 \text{ k}\Omega} = \frac{19.3}{470 \times 10^3} = 0.02404 \times 10^{-3} \text{ A} = 24.04 \times 10^{-6} \text{ A} = 24.04 \ \mu\text{A}$$
 
$$I_E = (\beta + 1)I_B = (101) \times 24.04 \ \mu\text{A} = 2.428 \text{ mA}$$
 
$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{2.428 \text{ mA}} = 10.71 \ \Omega$$

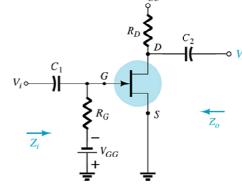
b.  $\beta r_e = 100 \times 10.71 \Omega = 1071 \Omega = 1.071 k\Omega$   $Z_i = R_B \| \beta r_e = \frac{R_B \times \beta r_e}{R_B + \beta r_e} = \frac{470 \times 1.071}{470 + 1.071} = 1.069 k\Omega$ 

$$Z_o = R_c \| r_o = \frac{R_C \times r_o}{R_C + r_{oe}} = \frac{3 \times 50}{3 + 50} = 2.83 \text{ k}\Omega$$

$$R_C \| r_o = 2.83 \text{ k}\Omega = 2.83 \times 10^3 \Omega = 2830$$

d. 
$$A_v = -\frac{R_c \| r_o}{r_e} = -\frac{2.83 \,\mathrm{k}\Omega}{10.71 \,\Omega} = -\frac{2.83 \times 10^3 \,\Omega}{10.71 \,\Omega} = -\frac{2830}{10.71} = -264.24$$

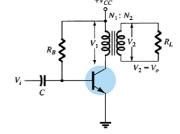
Ad-Soyad : No :					Email : mza :	
		Vize	2 (17.05.2010			
			22 – Elektro	•		
		S1	S2	S3	S4	Toplam
Aşağıdaki ifadele a. FET akım kont b. FET in giriş dire c. FET in gerilim ko d. JFET gerilim ko e. CMOS lojik kap	rollü aktif bir d enci BJT ye gö kazancı BJT y ontrollü bir dire	levre elemar öre daha yük e göre daha enç olarak ku	nıdır. sektir. yüksektir. ıllanılabilir.	( ) ( ) ( )	ya da Y şeklinde t	oelirtiniz. (25)
S2. Yandaki devrede $V, V_{GG} = 2 V \text{ ve } y$ $A_v = -3.48$ , giriş d verildiğine göre as a. $V_{GSQ}$ b. $I_{DQ}$ c. $r_d$ d. $g_m$ e. $R_G$ f. $R_D$ g. $V_D$	$_{ m os}$ = 40 $\mu { m S}$ olara irenci ${ m Z_i}$ = 1Ms	ak verilmiştir. <b>Ω</b> , çıkış direr	Devrenin gerilim oci $Z_0 = 1.85 \text{ k}\Omega$ o	kazancı	$V_i \circ \longrightarrow \downarrow $	$R_D = C_2$ $R_G = S$ $V_{GG}$



S3.

a. Kaç tür güç kuvvetlendiricisi vardır? Yazınız.

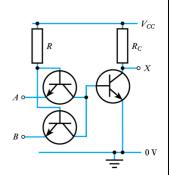
- (10)
- b. Şekildeki A sınıfı kuvvetlendiricisinde transformatörün kullanılmasının nedenlerini açıklayınız. (10)



S4.

a. Yandaki devrede tranzistörlerin ideal olduğunu varsayarak devrenin nasıl çalıştığını yandaki tabloyu doldurarak açıklayınız. (10)

Α	В	T <sub>A</sub>	T <sub>B</sub>	T <sub>X</sub>	Χ
0	V <sub>CC</sub>	on	off	off	V <sub>CC</sub>



b. Bu devre ne iş yapar? (5)

# Başarılar...

Hatırlatma:  $\boldsymbol{A}_{_{\boldsymbol{V}}} = -\boldsymbol{g}_{_{\boldsymbol{m}}}(\boldsymbol{r}_{_{\boldsymbol{d}}} \parallel \boldsymbol{R}_{_{\boldsymbol{D}}}) \qquad \quad \boldsymbol{I}_{\boldsymbol{D}} \! = \! \boldsymbol{I}_{\boldsymbol{D}SS} \! \left( \! \boldsymbol{1} \! - \! \! \frac{\boldsymbol{v}_{GS}}{\boldsymbol{v}_{\boldsymbol{P}}} \! \right)^{\! 2}$  $y_{os} = 1/r_d$ 

### **CEVAPLAR**

C1.

Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını yandaki parantez içinde D ya da Y şeklinde belirtiniz. (25)

a. FET akım kontrollü aktif bir devre elemanıdır.

b. FET in giriş direnci BJT ye göre daha yüksektir.

(D)

c. FET in gerilim kazancı BJT ye göre daha yüksektir.

(Y)

d. JFET gerilim kontrollü bir direnç alarak kullanılabilir.

(D)

e. CMOS lojik kapılar, TTL ye göre daha düşük güç harcarlar

C2.

a. 
$$V_{GS_O} = -V_{GG} = -2 \text{ V}$$

b. 
$$I_{D_Q} = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 = 10 \text{ mA} \left( 1 - \frac{2 \text{ V}}{-8 \text{ V}} \right)^2 = 10 \text{ mA} (1 - 0.25)^2 = 10 \text{ mA} (0.75)^2 = 5.625 \text{ mA}$$

c. 
$$r_d = \frac{1}{v_{os}} = \frac{1}{40 \,\mu\text{S}} = \frac{10^6}{40 \,\text{S}} = \frac{1000 \times 10^3}{40 \,\text{S}} = 25 \times 10^3 \,\Omega = 25 \,\text{k}\Omega$$

d. 
$$g_{m} = \frac{2I_{DSS}}{|V_{P}|} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{P}} \right) = \frac{2 \times 10 \text{ mA}}{|-8|} \left( 1 - \frac{2 \text{ V}}{-8 \text{ V}} \right) = 2.5 \times 0.75 = 1.875 \text{ mS}$$
 ya da 
$$g_{m} = -\frac{A_{v}}{Z_{o}} = -\frac{-3.48}{1.85 \times 10^{3}} = 1.88 \times 10^{3} \text{ S} = 1.88 \text{ mS}$$

e. 
$$R_G = Z_i = 1 \text{ M}\Omega$$

$$Z_{o} = r_{d} \parallel R_{D} \rightarrow Z_{o} = \frac{r_{d} \times R_{D}}{r_{d} + R_{D}} \rightarrow Z_{o} (r_{d} + R_{D}) = r_{d} R_{D} \rightarrow r_{d} Z_{o} = R_{D} (r_{d} - Z_{o}) \rightarrow R_{D} = R_{D}$$

$$R_{\rm D} = \frac{r_{\rm d} Z_{\rm o}}{(r_{\rm d} - Z_{\rm o})} = \frac{25 \,\mathrm{k}\Omega \times 1.85 \,\mathrm{k}\Omega}{(25 \,\mathrm{k}\Omega - 1.85 \,\mathrm{k}\Omega)} \cong 2 \,\mathrm{k}\Omega$$

g. 
$$V_D = V_{DD} - I_D \times R_D = 16 \text{ V} - 5.625 \text{ mA} \times 2 \text{ k}\Omega = 16 - 11.25 = 4.75 \text{ V}$$

h. 
$$V_G = V_{GS} = -2 \text{ V}$$
  $V_S = 0 \text{ V}$ 

C3.

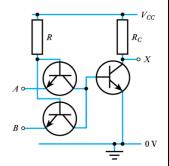
- A sınıfı, B sınıfı, AB sınıfı, C sınıfı ve D sınıfı güç kuvvetlendiricileri.
- Transformatör, yük ile tranzistor devresinin çıkışı arasında empedans uyumu ile birlikte devre ile yük arasında elektriksel izolasyonu sağlar.

C4.

a. A ve/veya B '0' a bağlandığında  $T_A$  ve/veya  $T_B$ iletimde, Tx kesimde olur. Bu durumda X çıkışı

A ve B 'Vcc' ye bağlandığında TA ve TB kesimde, Tx iletimde olur. Bu durumda X çıkışı '0' olur.

Α	В	T <sub>A</sub>	T <sub>B</sub>	T <sub>X</sub>	Х
0	0	on	on	off	$V_{CC}$
0	$V_{CC}$	on	off	off	$V_{CC}$
$V_{CC}$	0	off	on	off	V <sub>cc</sub>
V <sub>CC</sub>	$V_{CC}$	off	off	on	0



b. Bu bir NAND kapısıdır.

Ad-Soyad	:	Email :
No	:	İmza :

0112622 - Elektronik Devreler - Final (06.06.2011) - Süre 75 dk

S1 (15)	S2 (15)	S3 (35)	S4 (15)	S5 (15)	S6 (15)	Toplam

\_\_\_\_\_\_

S1. Aşağıdaki ifadelerde eksik olan kısımları doldurunuz.

(3+3+3+3+3=15)

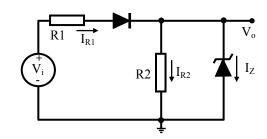
- a. Ideal bir işlemsel kuvvetlendiricide \_\_giriş direnci / kazanç\_\_ sonsuzdur.
- b. Fiziksel bir enerjiyi elektriksel enerjiye dönüştüren devre elemanına \_\_\_\_\_sensor\_\_\_ denir.
- c. Tranzistörlü devrelerin alternatif akım (AC) analizinde **\_\_kapasiteler / DC gerilim kaynakları**\_\_kısa devre varsayılırlar.
- d. Bir diyot test edilirken hem ileri yönde hem de geri yönde kutuplandığında **0 V** gösteriyorsa \_\_\_\_bozuktur\_\_\_\_.
- e. Ortak emitörlü devrede tranzistor doyma bölgesinde çalışıyorsa kollektor ve emitör arasındaki gerilim \_\_\_sıfırdır\_\_.

\_\_\_\_\_\_

S2.

Yandaki devrede  $V_i$  = 20 V, R1 = 0.9 k $\Omega$  ve R2 = 10 k $\Omega$  olarak verilmiştir. Diyodun iletim yönündeki gerilim düşümü  $V_D$  = 0.7 V, direnci  $r_D$  = 0.1 k $\Omega$  ve zener diyot gerilimi  $V_z$  = 5 V olduğuna göre;

 $\mathbf{V_o},\,\mathbf{I_{R1}},\,\,\mathbf{I_{R2}}$  ve  $\,\mathbf{I_Z}$  değerlerini bulunuz. (3+4+4+4=15)

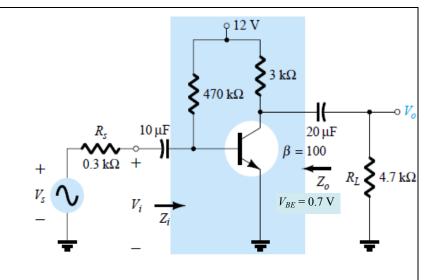


$$\begin{split} V_o &= V_Z = 5 \text{ V} \\ I_{R1} &= \frac{20 - V_D - V_o}{R1 + r_D} = \frac{20 - 0.7 - 5}{0.9 \text{ k}\Omega + 0.1 \text{ k}\Omega} = \frac{20 - 5.7}{1 \text{ k}\Omega} = \frac{14.3}{1000} = 0.0143 \text{ A} = 14.3 \text{ mA} \\ I_{R2} &= \frac{V_o}{R2} = \frac{5}{10 \text{ k}\Omega} = \frac{5}{10 \times 10^3} = 0.5 \times 10^{-3} \text{ A} = 0.5 \text{ mA} \\ I_Z &= I_{R1} - I_{R2} = 14.3 \text{ mA} - 0.5 \text{ mA} = 13.8 \text{ mA} \end{split}$$

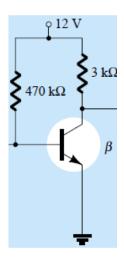


- a. Devrenin DC eşdeğerini çiziniz. (05)
- b.  $I_B$  akımını bulunuz. (05)
- c.  $V_{CE}$  gerilimini bulunuz. (05)
- d. Devrenin AC eşdeğerini çiziniz. (05)
- e.  $Z_i$  giriş direncini bulunuz. (05)
- f. Bu devrenin yüksüz gerilim kazancı  $A_{vNL}$  ise; kaynak ve yük direnci göz önüne alındığındaki devrenin gerilim kazancı ( $A_{vs}$ = $Vo/V_s$ ),  $A_{vNL}$  kazancına göre ne olur.

Nedenleriyle açıklayınız (10)



а

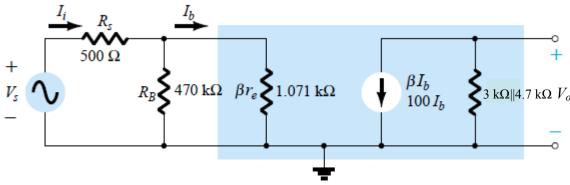


b

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12 - 0.7}{470 \text{ k}\Omega} = \frac{11.3 \text{ V}}{470 \text{ k}\Omega} \cong 0.024 \text{ mA} \cong 24 \text{ }\mu\text{A}$$

C.

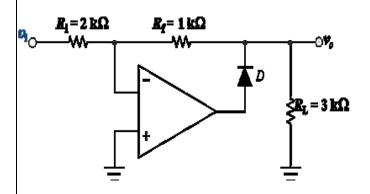
$$\begin{split} V_{CE} &= V_{CC} - I_C R_C = V_{CC} - \beta I_B R_C = 12 - 100 \times 0.024 \text{ mA} \times 3 \text{ k}\Omega \\ V_{CE} &= 12 - 2.4 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^3 = 12 - 2.4 \times 3 = 4.8 \text{ V} \end{split}$$

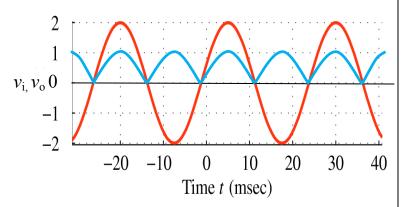


e. 
$$\beta r_e = 100 \times \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = 100 \times \frac{26 \text{ mV}}{(\beta + 1)I_B} = \frac{2600 \text{ mV}}{101 \times 0.024 \text{ mA}} = \frac{2600 \text{ mV}}{2.424 \text{ mA}} = 1072.6 \ \Omega \cong 1.072 \text{ k}\Omega$$
 
$$Z_i = R_B \parallel \beta r_e = \frac{470 \times 1.072}{470 + 1.072} = \frac{66.21}{471.072} = 1.0695 \text{ k}\Omega \cong 1070 \ \Omega$$

f. Kaynak ve yük direnci göz önüne alındığında devrenin gerilim kazancı  $A_{vs} = \frac{Z_i}{R_s + Z_i} \times \frac{R_L}{R_L + Z_o} \times A_{vNL}$  olur. Buna göre devrenin gerilim kazancı  $A_{vs}$  yüksüz durumdaki gerilim kazancı  $A_{vNL}$  den daha düşük olacaktır.

S4. Aşağıdaki devrede opamp ve diyot idealdir. Aşağıda verilen ( $v_i$ ) işareti devreye uygulandığında devrenin çıkışında elde edilecek olan ( $v_o$ ) işaretini çiziniz (çıkış dalga şeklini aynı grafik üzerine çizebilirsiniz). (15)





 $v_i$  < 0 olduğunda diyot iletimdedir ve devre kazancı -0.5 ( $K = v_o/v_i = -(R_f/R_i)$ ) olan eviren bir kuvvetlendirici olarak çalışır.

 $v_i > 0$  olduğunda diyot kesimdedir ve opamp devre dışıdır. Devre kazancı +0.5 ( $K = v_o/v_i = R_L/(R_f + R_i)$ ) olan pasif bir gerilim bölücü olarak çalışır.

\_\_\_\_\_

S5. Bir biyolojik ölçme sistemindeki sensörün çıkışında elde edilen elektriksel işaretin maksimum tepe değeri **10 mV** ve bantgenişliği **1 kHz** dir. Bu işaretin işlenebilmesi için kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. *Kazanç×Bant Genişliği* =**10**<sup>6</sup> olan gerçek bir opamp kullanıldığına göre; belirlenen çalışma frekans aralığı içinde çıkış tepe değeri maksimum **1 V** olacak sekilde (evirmeyen) kazanç sağlayan kuvvetlendirici devresini tasarlayınız.

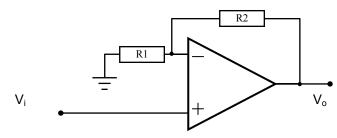
Tasarlanması istenen kuvvetlendiricinin Kazancı ( $K_{amp}$ ) = 1 V / 10 mV = 1 / ( $10 \times 10^{-3}$ ) =  $10^{2}$ , Bant Genişliği (BG)  $10^{3}$  Hz olarak verilmiş.

Bu kuvvetlendirici için  $K_{amp} \times BG = 10^2 \times 10^3 = 10^5$ , kullanılacak olan opamp ın  $K_{op} \times BG$  değerinden (10<sup>6</sup>) daha azdır.

Bir opamp la tasarlanacak 1 kHz bant genişliğine sahip kuvvetlendiriciden elde edilebilecek en yüksek kazanç;

$$K_{1op} \times BG = 10^6 \rightarrow K_{1op} \times 10^3 = 10^6 \rightarrow K_{1op} = 10^6 \times 10^{-3} = 10^3$$

Bu durumda tasarlanması istenen kuvvetlendirici sistem, kazancı 100 olan tek opamplı evirmeyen bir kuvvetlendirici kullanılarak aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir.

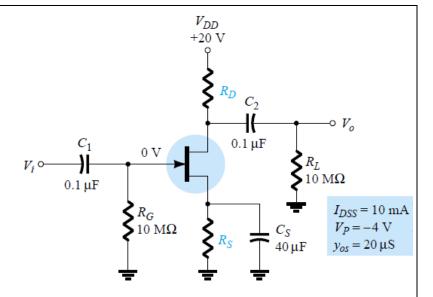


Evirmeyen kuvvetlendirici için;

$$K = 1+(R2/R1) = 100$$
  $\rightarrow$   $R2 = 99 \times R1$   $\rightarrow$   $R1 = 1 kΩ$  seçilirse  $R2 = 99 kΩ$ 

S6.

Yandaki devrenin gerilim kazancı Av = -8 ve  $V_{GSQ} = \frac{1}{4}V_P$  olarak verildiğine göre  $R_D$  direnç değerini bulunuz. (



$$V_{GSQ} = V_{GS} = \frac{V_p}{4} = \frac{-4}{4} = -1 \text{ V}$$

$$A_{v} = -g_{m}(r_{d} \parallel R_{D}) = -g_{m} \frac{r_{d} \times R_{D}}{r_{d} + R_{D}} \implies -8 = -g_{m} \frac{r_{d} \times R_{D}}{r_{d} + R_{D}} \implies 8 = g_{m} \frac{r_{d} \times R_{D}}{r_{d} + R_{D}} \implies 8 = g_{m} \frac{r_{d} \times R_{D}}{r_{d} + R_{D}} \implies 8r_{d} + 8R_{D} = g_{m} \times r_{d} \times R_{D} \implies 8r_{d} = (g_{m} \times r_{d} - 8)R_{D} \implies R_{D} = \frac{8r_{d}}{g_{m} \times r_{d} - 8}$$

r<sub>d</sub> ve g<sub>m</sub> yi hesaplayıp yukarıda yerine koyarsak R<sub>D</sub> yi bulmuş oluruz.

$$\begin{split} y_{os} &= \frac{1}{r_d} \implies r_d = \frac{1}{y_{os}} = \frac{1}{20 \, \mu S} = \frac{10^6}{20} = \frac{1000000}{20} = 50000 \, \Omega = 50 \, k\Omega \\ g_m &= \frac{2I_{DSS}}{\left|V_P\right|} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right] = \frac{2 \times 10 \, mA}{4 \, V} \left[1 - \frac{-1}{-4}\right] = 5 \times 0.75 \, mS = 3.75 \, mS \end{split}$$

$$R_{_{D}} = \frac{8r_{_{d}}}{g_{_{m}} \times r_{_{d}} - 8} = \frac{8 \times 50 \times 10^{3}}{3.75 \times 10^{^{-3}} \times 50 \times 10^{^{3}} - 8} = 2228 \ \Omega \cong 2.2 \ k\Omega$$

Ortak-Emitörlü Tranzistor eşdeğer devresi

$$\beta r_{e}$$

$$\beta I_{b}$$

$$\beta I_{b}$$

$$\beta I_{b}$$

$$\beta I_{b}$$

$$\beta I_{b}$$

$$\beta I_{c}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$g_{e} = \frac{I_{E}}{26 \text{ mV}}$$

$$I_{e} = \frac{I_{E}}{26 \text{ mV}}$$

$$I_{C} = \beta I_{B}$$

$$g_{e} = \frac{I_{E}}{26 \text{ mV}}$$

$$A_{vs} = \frac{Z_{i}}{R_{s} + Z_{i}} \times \frac{R_{L}}{R_{L} + Z_{o}} \times A_{vNL}$$

$$S \circ \longrightarrow \downarrow$$

$$V_{gs} \downarrow g_{m}V_{gs} \downarrow r_{d}$$

$$A_{vg} = \frac{2I_{DSS}}{|V_{P}|} \left[ 1 - \frac{V_{GS}}{V_{P}} \right]$$

$$A_{vg} = -g_{m}(r_{d} \parallel R_{D})$$

$$g_{\rm m}$$

$$y_{os} = 1/r_{d} I_{D=I_{DSS}} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{P}}\right)^{2}$$

$$A_{v} = -g_{m}(r_{d} \parallel R_{D})$$

Ad-Soyad:

Email:

No :

imza :

# 0112622 - Elektronik Devreler - Vize 1 (04.04.2011) - Süre 75 dk

S1 (15)	S2 (15)	S3 (20)	S4 (15)	S5 (20)	S6 (15)	Toplam

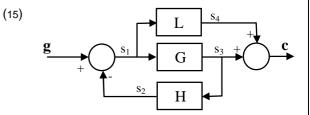
- S1. Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını yandaki parantez içinde **D** ya da **Y** şeklinde belirtiniz. (3+3+3+3+3=15)
  - a. Transducer bir enerji türünü başka bir enerji türüne dönüştüren devre elemanıdır. (D)
  - b. Doğruluk (accuracy) gerçek değerle ölçülen değer arasındaki farktır.

(Y) (Y)

(D)

c. İdeal op-amp ın giriş direnci sıfırdır.

- (Y) (D)
- d. Bir diyot test edilirken hem ileri yönde hem de geri yönde kutuplandığında 0 V gösteriyorsa bozuktur.
- e. Girişine tepe değeri V<sub>m</sub> olan bir işaret uygulanan tam dalga doğrultucusunun ortalama çıkış gerilimi **0.636V**<sub>m</sub> dir.
- S2. Yanda verilen sisteme ait transfer fonksiyonunu (**c/g**) bulunuz.



C2.

$$s_3 = s_1 \times G$$

$$c = s_3 + s_4 = s_3 + s_1 \times L = s_1 \times L + s_1 \times G = s_1 \times (L + G)$$

$$s_1 = \frac{c}{L + G}$$

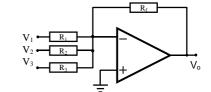
$$s_2 = s_3 \times H$$

$$s_1 = g - s_2 = g - s_3 \times H = g - s_1 \times G \times H \rightarrow g = s_1 + s_1 \times G \times H = s_1 (1 + G \times H)$$

$$g = \frac{c}{L+G}(1+G\times H) = c\frac{1+GH}{L+G} \rightarrow \frac{c}{g} = \frac{L+G}{1+GH}$$

S3. Yandaki devrede 
$$R_1$$
= 200 k $\Omega$ ,  $R_2$ = 100 k $\Omega$ ,  $R_3$ = 50 k $\Omega$ , ve  $R_f$  = 10 k $\Omega$  olarak verildiğine göre;

(a) Devrenin çıkış ifadesini (**V**<sub>0</sub>) bulunuz.



(10)

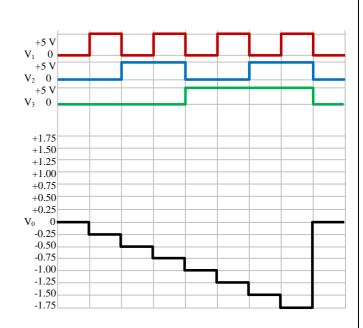
$$\frac{0 - V_1}{R_1} + \frac{0 - V_2}{R_2} + \frac{0 - V_3}{R_3} + \frac{0 - V_0}{R_f} = 0 \implies$$

$$-\left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}\right) = \frac{V_0}{R_f} \implies$$

$$V_0 = -\left(\frac{R_f V_1}{R_1} + \frac{R_f V_2}{R_2} + \frac{R_f V_3}{R_3}\right)$$

$$V_0 = -\left(\frac{10V_1}{200} + \frac{10V_2}{100} + \frac{10V_3}{50}\right)$$

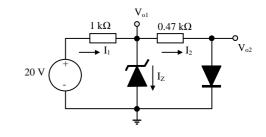
$$V_0 = -(0.05V_1 + 0.1V_2 + 0.2V_3)$$



(b) Giriş işaretleri ( $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$ ) yandaki gibi verildiğine göre çıkış işaretini ( $V_0$ ) tamamlayınız. (10)

S4. Yandaki diyot devresinde  $V_{o1}$ ,  $V_{o2}$ ,  $I_1$ ,  $I_2$  ve  $I_Z$  değerlerini bulunuz. (3+3+3+3+3=15)

$$V_F = 0.7 V$$
  $V_Z = 5.4 V$ 



C4.

$$\begin{split} &V_{o1} = V_Z = 5.4 \text{ V}, \quad V_{o2} = 0.7 \text{ V} \\ &I_1 = \frac{20 - V_{o1}}{1 \text{ k}\Omega} = \frac{20 - 5.4}{1000} = \frac{14.6}{1000} = 0.0146 \text{ A} = 14.6 \text{ mA} \\ &I_2 = \frac{V_{o1} - V_{o2}}{0.47 \text{ k}\Omega} = \frac{5.4 - 0.7}{470} = \frac{4.7}{470} = 0.01 \text{ A} = 10 \text{ mA} \\ &I_Z = I_1 - I_2 = 14.6 \text{ mA} - 10 \text{ mA} = 4.6 \text{ mA} \end{split}$$

S5. **0-100 kHz** frekans aralığında kazancı **10**<sup>3</sup> olan evirmeyen bir kuvvetlendirici tasarlanacaktır. *Kazanç×Bant Genişliği* **10**<sup>6</sup> olan bir opamp kullanıldığına göre; belirlenen çalışma frekans aralığı içinde istenen kazancı sağlayan devreyi tasarlayınız (gerekiyorsa birden fazla opamp devresi kullanabilirsiniz). (20)

\_\_\_\_\_

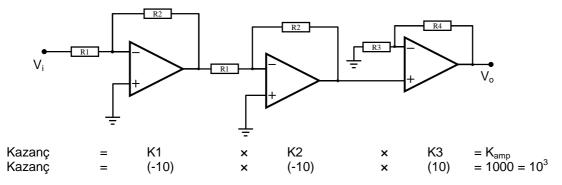
C5. Tasarlanması istenen kuvvetlendiricinin Kazancı (K<sub>amp</sub>) 10³, Bant Genişliği (BG) 10⁵ olarak verilmiş.

Bu kuvvetlendirici için  $K_{amp} \times BG = 10^3 \times 10^5 = 10^8$ , kullanılacak olan opamp ın  $K_{op} \times BG$  değerinden (10<sup>6</sup>) daha yüksektir.

Buna göre bir opamp la tasarlanacak 100 kHz bant genişliğine sahip kuvvetlendiriciden elde edilebilecek en yüksek kazanç;

$$K_{1op} \times BG = 10^6$$
  $\rightarrow$   $K_{1op} \times 10^5 = 10^6$   $\rightarrow$   $K_{1op} = 10^6 \times 10^{-5} = 10$ 

Tasarlanması istenen kuvvetlendirici system, kazancı 10 olan tek opamp lı üç farklı kuvvetlendiricinin arka arkaya bağlanmasıyla elde edilebilir. Buna göre kuvvetlendirici sistemi, herbirinin kazancı 10 olan iki eviren ve bir evirmeyen kuvvetlendirici kullanılarak aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir.



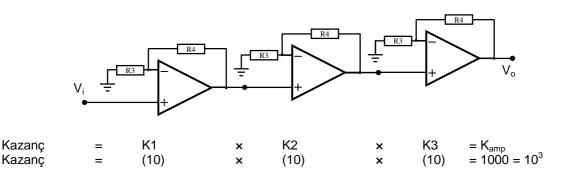
Eviren kuvvetlendirici için;

$$K_1 = K_2 = -(R2/R1) = -10$$
  $+$ 

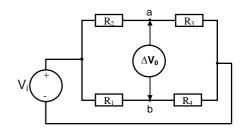
Evirmeyen kuvvetlendirici için;

$$K_3 = 1 + (R4/R3) = 10$$
  $\Rightarrow$   $R4 = 9 \times R3$   $\Rightarrow$   $R3 = 1 \times \Omega$  secilirse  $R4 = 9 \times \Omega$ 

Diğer bir çözüm ise yukarıda tasarımı yapılan kazancı 10 olan evirmeyen kuvvetlendiricinin aşağıdaki gibi 3 defa arka arkaya bağlanması ile elde edilir.



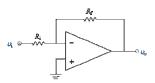
S6. Hassas bir terazide kullanılan yandaki Wheatstone köprü devresinde tartılan cismin ağırlığı  $\bf a$  ve  $\bf b$  noktaları arasında ölçülen gerilimle ( $\Delta V_0$ ) orantılıdır. Köprüyü oluşturan bütün dirençlerin ( $\bf R_1$ ,  $\bf R_2$ ,  $\bf R_3$ ,  $\bf R_4$ ) değerleri tartılan cismin oluşturduğu basınçla değişmektedir ve başlangıç değerleri  $\bf R_0$  olarak verilmiştir. Ağırlık ölçülürken  $\bf R_1$  ve  $\bf R_3$   $\Delta \bf R$  kadar artmakta,  $\bf R_2$  ve  $\bf R_4$  ise  $\Delta \bf R$  kadar azalmaktadır. Buna göre ölçü aletinden okunan  $\Delta \bf V_0$  değerinin ( $\Delta \bf R/\bf R_0$ )× $\bf V_i$  olduğunu gösteriniz. (15)



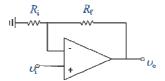
C6.

$$\begin{split} R_1 &= R_3 = R_0 + \Delta R \quad , \quad R_2 = R_4 = R_0 - \Delta R \\ V_a &= V_i \! \left( \frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) \quad V_b = V_i \! \left( \frac{R_4}{R_1 + R_4} \right) \quad \Delta V_o = V_a - V_b = V_i \! \left( \frac{R_3}{R_2 + R_3} - \frac{R_4}{R_1 + R_4} \right) \\ \Delta V_o &= V_i \! \left( \frac{R_0 + \Delta R}{R_0 - \Delta R + R_0 + \Delta R} - \frac{R_0 - \Delta R}{R_0 + \Delta R + R_0 - \Delta R} \right) \! = V_i \! \left( \frac{R_0 + \Delta R}{R_0 + R_0} - \frac{R_0 - \Delta R}{R_0 + R_0} \right) \\ \Delta V_o &= V_i \! \left( \frac{R_0 + \Delta R - R_0 + \Delta R}{2 \times R_0} \right) \! = V_i \! \left( \frac{2 \times \Delta R}{2 \times R_0} \right) \! = V_i \! \left( \frac{\Delta R}{R_0} \right) \end{split}$$

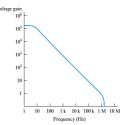
Hatırlatma



Eviren (inverting) kuvvetlendirici



Evirmeyen (noninverting) kuvvetlendirici



Opamp Kazanç-Bant Genişliği grafiği